



## 三维悬空环栅结构半导体场效应晶体管器件的制备方法

**专利名称:** 三维悬空环栅结构半导体场效应晶体管器件的制备方法  
**专利类别:** 发明  
**申请号:** 2019110871355  
**第一发明人:** 顾长志  
**其它发明人:** 孙驰;杨海方;金爱子;李俊杰  
**专利授权日期:** 2021-06-22

[关闭窗口](#)

